

— 2003年（平成15年）秋季 —

第64回応用物理学会学術講演会

プ ロ グ ラ ム

と き 2003年8月30日(土), 31日(日), 9月1日(月), 2日(火)

ところ 福岡大学（七隈キャンパス）

福岡市城南区七隈8-19-1

TEL 092 (866) 2943 (大会本部直通)

主催／社団法人 応用物理学会 協賛／福岡大学

講演分科日程表 (分科別) I

福岡大学 七隈キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	8月30日(土)		8月31日(日)		9月1日(月)		9月2日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
本部共通行事								
第25回応用物理学会 論文賞授賞式	文系センター棟4F第4会議室 15 17:30-17:50							
第3回応用物理学会 業績賞受賞記念講演	10-YA 9 11:00-12:00							
第14回応用物理学会 講演奨励賞贈呈式	8-Y 15 12:30-13:30							
応用物理学会論文賞 受賞記念講演 (JJAP 論文賞)				A-G 10 13:00-13:30 8-ZB 13:30-14:00 8-ZF 14:00-14:30		8-V 10 13:00-13:30 10-YD 14:00-14:30		
応用物理学会論文賞 受賞記念講演 (JJAP 論文奨励賞)		10-YB 10 13:30-13:50		11-YL 10 13:10-13:30 10-YB 14:00-14:20	A-F 10 11:00-11:20			
応用物理学会論文賞 受賞記念講演 (解説論文賞)		11-YL 10 13:00-13:30		10-YK 10 14:00-14:30				
第1回プラズマエレクトロニクス賞 受賞記念講演				10-YA 10 13:30-14:00				
第3回光・量子エレクトロニクス業績 賞授賞式・記念講演						8-ZD 10 13:30-14:10		
第1回有機分子・バイオエレクトロニ クス分科会論文賞受賞記念講演						11-YL 10 13:00-14:00		
第33回応用物理学会スクールA「応用 物理のための材料の構造・組成・電子状 態解析のポイントとノウハウ」						A-C 11 9:30-16:45		
第33回応用物理学会スクールB「有機 デバイスとその発展の最前線：パート 1材料編-応用物理学会-高分子学会連 携研究会-」							A-F 12 9:00-17:00	
応用物理学会評議員・代議員合同会議	文系センター棟4F第4会議室 15 16:30-17:30							
懇親会	文系センター棟16Fスカイラウンジ15 18:00-19:30							
1. 放射線・プラズマエレクトロニクス								
1.1 放射線・加速器・原子炉			A-C 26 9:00-11:30		10-YG(ショート) 10:00-12:05	→ポスター 27 15:30-17:30	10-YG 27 10:00-12:30	
1.2 プラズマ生成技術およびプラ ズマ源	8-R 27 9:00-12:00	8-R 28 13:00-16:15						
1.3 反応性プラズマの診断と計測			8-R 28 9:00-12:15		8-N 28 9:00-12:30			
1.4 プラズマ応用プロセス			10-YA 28 9:45-12:30		8-ZG 28 9:00-12:30	8-ZG 29 13:30-18:30		
1.5 プラズマプロセスによるナノ テクノロジー							8-Q 29 9:00-11:15	
1.6 プラズマ現象一般	8-Q 29 9:30-12:00	8-Q 29 13:00-16:00						
2. 計測・制御								
2.1 計測一般							8-ZH 30 9:15-13:00	
2.2 制御・情報処理応用計測								
2.3 計測標準・精密計測					8-ZH 30 10:00-12:30			
3. 光								
3.1 物理光学・光学基礎					8-ZK(ショート) 10:00-10:35	→ポスター 30 13:00-15:00		
3.2 材料光学	8-W 30 9:30-12:30	8-W 30 13:30-15:15						
3.3 機器・デバイス光学			8-W 30 9:00-12:15	8-W 31 13:15-18:30				
3.4 計測光学					8-W 31 9:45-12:30	8-W 31 13:30-18:15	8-W 32 9:30-12:30	
3.5 情報光学				8-T 32 14:00-18:45				
3.6 視覚・色彩				8-T 32 13:30-14:00				
3.7 生体・医用光学			8-Q 32 9:30-12:00	8-Q 32 13:15-17:00				
3.8 近接場光学					8-Q 33 9:00-12:00	8-Q 33 13:00-18:15		
3.9 光学新領域					8-ZK(ショート) 10:35-11:10	→ポスター 33 13:00-15:00		
4. 量子エレクトロニクス								
4.1 量子光学・原子光学								
4.2 フォトニックナノ構造・現象			8-ZM 33 9:30-13:00	8-ZM 33 14:00-18:30	8-ZM 34 9:30-13:00	8-ZM 34 14:00-18:30	8-ZM 34 9:00-12:00	8-ZM 35 13:00-15:00
4.3 レーザー装置・材料	8-X 35 9:30-12:30	8-X 35 13:30-17:15	8-X 35 9:30-12:30	8-X 35 13:30-16:45				
4.4 超高速・高強度レーザー	8-ZB 36 9:30-12:30	8-ZB 36 13:30-17:15	8-ZB 36 9:30-12:30	8-ZB 36 13:30-17:45				
4.5 非線型光学					8-ZD 37 9:15-12:30	8-ZD 37 13:30-19:10	8-ZD 37 9:00-12:15	8-ZD 37 13:15-15:00
4.6 レーザー分光応用・計測							8-ZC 38 9:00-12:30	
4.7 レーザー・プロセッシング	8-ZQ 38 9:30-12:30	8-ZQ 38 13:30-17:30	A-F 38 9:00-11:45		8-ZQ 39 10:00-13:00	8-ZQ 39 14:00-18:45	8-ZQ 39 10:00-12:15	

注：P1-P10はポスターセッションのみ。(場所は第一記念会堂(体育館))
会場名の前は、号館を表示(例：A-CはA棟のC会場、10-YGは10号館のYG会場)
シンポジウム9頁参照

講演分科日程表 (分科別) II

福岡大学 七隈キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	8月30日(土)		8月31日(日)		9月1日(月)		9月2日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
5. 光エレクトロニクス								
5.1 半導体レーザー・発光素子	10-YB 39 9:30-12:30	10-YB 39 13:30-17:05	10-YC 40 9:30-12:30	10-YC 40 13:30-15:45				
5.2 光検出					10-YH 40 9:30-11:45			
5.3 光記録			10-YD(ショート) 10:00-11:35	→ポスター 40 13:00-15:00				
5.4 光制御	10-YH 41 9:30-13:00 10-YK 41 9:30-13:00	10-YH 41 14:00-16:45 10-YK 41 14:00-17:45	10-YK 42 10:00-13:00	10-YK 42 14:00-18:45	10-YK 42 10:00-13:00	10-YK 42 14:00-18:15	10-YK 43 9:00-11:45	10-YK 43 12:45-14:30
5.5 光ファイバー			10-YH 43 10:00-13:00	10-YH 43 14:00-18:45				
6. 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜	8-T 43 9:00-12:00 8-V 44 9:00-12:00	8-T 44 13:00-17:45 8-V 44 13:00-17:45	8-T 44 9:00-12:00 8-V 45 9:00-12:00		8-V 45 9:00-12:00	8-V 45 13:00-18:15	8-V 45 9:00-12:00	8-V 46 13:00-15:00
6.2 カーボン系薄膜			8-Y 46 9:30-12:30	8-Y 46 13:30-17:30	8-Y 46 9:30-12:30	8-Y 46 13:30-18:00	8-Y 47 9:00-12:00	8-Y 47 13:00-14:30
6.3 酸化物エレクトロニクス						P8 47 13:00-15:00	P10 48 9:30-11:30	
6.4 薄膜新材料	8-ZA 48 9:30-12:30	8-ZA 48 13:30-17:45	8-ZA 49 9:30-12:30	8-ZA 49 13:30-18:15	8-ZA 49 9:30-12:30	8-ZA 49 13:30-18:15	8-ZA 50 9:30-11:30	
6.5 表面物理・真空			8-ZC 50 10:00-12:15	8-ZC 50 13:30-17:30	8-ZC 50 10:00-12:15	8-ZC 50 13:30-17:00		
6.6 プローブ顕微鏡	A-D 51 9:00-12:00		8-ZD 51 9:30-12:30	8-ZD 51 13:30-16:45				
7. ビーム応用								
7.1 X線技術	8-ZK 51 9:30-12:30	8-ZK 52 13:30-17:30						
7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析					8-ZN 52 10:00-12:00			
7.3 リソグラフィ	8-L(ショート) 11:00-12:00	→ポスター 52 15:30-17:30	8-ZQ 52 10:00-13:00	8-ZQ 53 14:00-18:00	8-R 53 9:00-12:00	8-R 53 13:00-17:45		
7.4 ビーム励起表面反応	10-YD 53 ※9:30-13:00	10-YD 54 ※14:00-17:45						
7.5 イオンビーム一般						8-ZK 54 14:00-18:45	8-ZK 54 9:00-12:00	8-ZK 54 13:00-15:00
7.6 プラズマ・イオン・光プロセス			8-ZK 55 9:45-13:00	8-ZK 55 14:00-18:45				
7.7 微小電子源							10-YH 55 9:00-12:00	10-YH 55 13:00-14:45
7.8 ビーム応用一般・新技術			8-ZH 55 10:00-11:30					
8. 応用物性								
8.1 磁性材料・磁気デバイス	10-YE 56 10:00-13:00	10-YE 56 14:00-16:30						
8.2 誘電材料・誘電体			10-YE 56 10:00-13:00	10-YE 56 14:00-17:00				
8.3 微粒子・粉体						P9 56 15:30-17:30		
8.4 ナノエレクトロニクス	10-YF 56 11:45-13:00	10-YF 57 14:00-17:00						
8.5 熱電変換			10-YF 57 10:00-13:00	10-YF 57 14:00-18:45	10-YF 57 10:00-13:00			
8.6 新機能材料・新物性						10-YF 58 14:00-16:45		
9. 超伝導								
# 分科内総合講演					A-D 58 9:00-12:00			
9.1 基礎物性		8-ZG 58 14:00-17:45	8-ZG 58 10:00-12:45	8-ZG 58 14:00-17:00				
9.2 臨界電流, 超伝導応用			8-N 59 9:00-12:00	8-N 59 13:00-18:15				
9.3 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス	8-ZG 59 9:45-13:00							
9.4 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	A-K 60 9:00-12:00	A-K 60 13:00-17:30						
9.5 アナログ応用および関連技術			A-A 60 9:00-12:00			8-X 60 13:30-18:00	8-X 61 9:00-11:30	
9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用						8-N 61 13:30-17:45	8-N 61 9:00-12:15	

注: P1-P10 はポスターセッションのみ。(場所は第一記念会堂(体育館))
 会場名の前は、号館を表示(例: 10-YB は10号館のYB会場, A-DはA棟D会場)
 ※分科内招待講演があります。
 # 分科内総合講演「応用物理における超伝導研究の新展開」
 シンポジウム9頁参照

講演分科日程表（分科別）III

福岡大学 七隈キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	8月30日(土)		8月31日(日)		9月1日(月)		9月2日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
10. 有機分子・バイオエレクトロニクス								
10.1 作製技術	11-YL(ショート) 9:15-11:45	→ポスター 61 13:00-15:00	A-D(ショート) 9:20-11:45	→ポスター 62 13:00-15:00				
10.2 評価・基礎物性					8-L 62 9:00-12:00	8-L 63 13:00-18:00	8-L 63 9:00-13:00	
10.3 分子エレクトロニクス					8-S 63 9:00-12:00	8-S 63 13:00-17:30	8-S 64 9:15-12:00	8-S 64 13:00-15:00
10.4 分子フォトニクス			8-L 64 9:00-12:00	8-L 64 13:00-18:15				
10.5 液晶		8-L 65 13:00-17:30						
10.6 高分子・ソフトマテリアル						10-YG 65 13:00-18:00		
10.7 生物・医用工学・バイオチップ	8-S 65 9:00-12:00	8-S 65 13:00-17:45	8-S 66 9:00-12:00	8-S 66 13:00-14:45				
10.8 特定テーマA 有機デバイス			11-YL 66 9:30-12:00	11-YL 66 13:10-18:15	11-YL 67 9:30-12:00	11-YL 67 13:00-17:15	11-YL 67 10:00-12:00	11-YL 67 13:00-15:00
10.9 特定テーマB 分子・バイオナノテクノロジー					8-T 67 9:30-12:30	8-T 68 13:30-19:15		
11. 半導体A(シリコン)								
11.1 基礎物性・評価	A-A 68 9:00-12:00	A-A 68 13:00-16:15						
11.2 半導体表面					10-YC 68 10:00-13:00	10-YC 69 14:00-19:15	10-YC 69 9:00-12:00	10-YC 69 13:00-15:00
11.3 絶縁膜技術		11-YL 69 13:00-17:45	P3 70 9:30-11:30	P5 71 15:30-17:30	P6 71 9:30-11:30			
		P2 70 15:30-17:30						
11.4 配線技術			10-YB 71 10:00-13:00	10-YB 71 14:00-19:20	10-YB 72 10:00-13:00	10-YB 72 14:00-19:00		
11.5 Si プロセス技術				A-A 72 13:00-17:45	A-A 73 9:00-12:00	A-A 73 13:00-17:45	A-A 73 9:00-12:00	A-A 75 13:00-15:00
11.6 Si デバイス/集積化技術				10-YD 74 14:00-18:30	10-YD 74 10:00-12:45	10-YD 74 14:00-18:45	10-YD 74 9:00-11:45	10-YD 74 13:00-15:00
11.7 シミュレーション	8-N 75 9:00-11:45							
12. 半導体B(探索的材料・物性・デバイス)								
12.1 探索的材料物性					8-ZB 75 9:30-12:30	8-ZB 75 13:30-18:00	8-ZB 76 9:30-12:30	8-ZB 76 13:30-14:45
12.2 超薄膜・量子ナノ構造	8-ZF 76 9:00-12:00	8-ZF 76 13:00-17:45	8-ZF 77 10:00-13:00	8-ZF 77 14:00-19:00	8-ZF 77 10:00-13:00	8-ZF 77 ※14:00-19:00		
12.3 プロセス技術・界面制御		A-C 78 ※13:00-17:30						
12.4 超高速・機能デバイス					P7 78 9:30-11:30			
12.5 半導体光物性・光デバイス	8-ZE 78 9:30-12:00	8-ZE 79 13:00-17:30	8-ZE 79 10:00-12:30	8-ZE 80 ※13:30-17:15	8-ZE 80 9:30-12:30	8-ZE 80 13:30-18:30	8-ZE 80 9:30-12:45	
	8-ZL 79 10:00-13:15	8-ZL 79 14:00-17:45						
13. 結晶工学								
13.1 バルク結晶成長	P1 81 9:30-11:30							
13.2 II-VI 族結晶	A-B 81 10:30-11:45	A-B 81 13:00-17:15	A-B 82 9:00-12:00	A-B 82 13:00-18:30				
13.3 III-V 族エピタキシャル結晶			A-K 82 9:00-12:00	A-K 82 13:00-17:45	A-K 83 9:00-12:00	A-K 83 13:00-17:45	A-K 83 9:00-11:45	
13.4 III-V 窒化物結晶	A-F 83 9:00-12:00		A-G 84 9:00-12:00	A-G 84 13:00-17:45	A-G 85 9:00-12:00	A-G 85 13:00-17:45	A-G 86 9:00-12:00	A-G 86 13:00-15:00
	A-G 84 9:00-12:00	A-G 84 13:00-17:30		8-R 85 13:45-17:30	A-H 86 9:00-11:45		A-H 86 9:00-12:15	
13.5 IV 族結晶, IV-IV 族結晶			A-H 86 9:00-12:00	A-H 87 13:00-17:00				
13.6 IV 族系化合物					A-B 87 9:00-12:15	A-B 87 13:15-17:45	A-B 87 9:00-12:00	A-B 88 13:00-15:00
13.7 エピタキシーの基礎					10-YA 88 9:30-12:30			
13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥					8-X 88 9:00-12:00		10-YA 88 9:00-12:15	10-YA 88 13:00-15:45

注：P1-P10はポスターセッションのみ。（場所は第一記念会堂（体育館））
 会場名の前は、号館を表示（例：11-YLは11号館のYL会場、A-DはA棟のD会場）
 ※分科内招待講演があります。
 シンポジウム9頁参照

講演分科日程表（分科別）Ⅳ

福岡大学 七隈キャンパス

大分類分科名 中分類分科名	8月30日(土)		8月31日(日)		9月1日(月)		9月2日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
14. 非晶質								
14.1 基礎物性・評価					10-YE 89 10:00-13:00	10-YE 89 14:00-19:30		
14.2 プロセス技術					A-F 89 #9:00-12:20	10-YH 89 13:30-17:30		
14.3 デバイス						10-YH 90 17:30-18:15	10-YE 90 9:00-10:45	
15. 応用物理一般								
15.1 応用物理一般				10-YG 90 14:00-16:30				
15.2 教育			P4 90 9:30-11:30					
15.3 新技術		10-YG 90 14:00-17:45						
15.4 トライボロジー		10-YG 91 13:30-14:00						
15.5 エネルギー変換・貯蔵			10-YG 91 10:00-12:30					
15.6 資源・環境			10-YG 91 12:45-13:15					
15.7 磁場応用	10-YC 91 9:00-13:00							
合同セッション								
合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」							8-ZF 91 9:15-12:00	8-ZF 91 13:00-15:00
合同セッションE「スピンエレクトロニクスの基礎と応用」		A-H 92 13:00-17:15	8-ZL 92 10:00-13:00	8-ZL 92 14:00-18:30	8-ZL 92 #10:00-13:00		8-ZL 93 10:00-13:00	
合同セッションF「カーボンナノチューブの基礎と応用」	10-YA 93 ※9:15-12:00	A-E 93 13:00-17:45	A-E 93 9:30-12:00	A-E 94 13:00-17:30	A-E 94 9:30-12:00	A-E 94 #13:00-18:00	A-E 94 9:00-12:00	
合同セッションG「量子情報の基礎と応用」	8-ZC 95 9:30-12:30	8-ZC 95 13:30-15:45						

注：P1-P10 はポスターセッションのみ。（場所は第一記念会堂（体育館））

会場名の前は、号館を表示（例：10-YE は10号館のYE会場）

※応用物理学会業績賞受賞記念講演時間を含む9頁参照。

分科内招待講演があります。

シンポジウム9頁参照

日程表 (会場別) 1

福岡大学 七隈キャンパス

会場	収容数	8月30日(土)		8月31日(日)		9月1日(月)		9月2日(火)			
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後		
A棟	A 地下1F-AB01	448	11.1 基礎物性・評価	11.1 基礎物性・評価	9.5 アナログ応用および関連技術	11.5 Siプロセス技術	11.5 Siプロセス技術	11.5 Siプロセス技術	11.5 Siプロセス技術	11.5 Siプロセス技術	11.5 Siプロセス技術
	B 地下1F-AB02	283	13.2 II-VI族結晶	13.2 II-VI族結晶	13.2 II-VI族結晶	13.2 II-VI族結晶	13.6 IV族系化合物	13.6 IV族系化合物	13.6 IV族系化合物	13.6 IV族系化合物	13.6 IV族系化合物
	C 1F-A101	200		12.3 プロセス技術・界面制御	1.1 放射線・加速器・原子炉	「先端固体放射線検出器の開発動向」	第33回応用物理学会スクールA 「応用物理のための材料の構造・組性・電子状態解析のポイントとノウハウ」				
	D 2F-A201	448	6.6 プローブ顕微鏡	薄膜・表面物理分科会企画「原子レベル制御ナノテクノロジー：A Pre-Symposium of ACSIN-7」シンポジウム	10.1 作製技術	結晶工学分科会企画シンポジウム「太陽電池の結晶工学—低コスト・高効率・大面積・高信頼性を求めて—」	9. 超伝導分科内総合講演「応用物理における超伝導研究の進展」	「GaN電子デバイスの進展と実用化への課題」			
	E 2F-A202	200		合同セッションD「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションD「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションD「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションD「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションD「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションD「カーボンナノチューブの基礎と応用」	合同セッションD「カーボンナノチューブの基礎と応用」	
	F 2F-A203	283	13.4 III-V窒化物結晶	「ナノ光学と分子スケールエレクトロニクス」のセッション」	4.7 レーザー・プロセッシング	「フェムト秒レーザーを用いたリアルプロセッシングの新展開」	応用物理学会論文賞 JJAP論文奨励賞 14.2 プロセス技術	「ランダム系有機・無機薄膜トランジスタの新展開」	第33回応用物理学会スクールB 「有機分子・バイオエレクトロニクス分科会企画、高分子学会共催」有機デバイスとその発展の最前線：パート1 材料編		
	G 4F-A401	448	13.4 III-V窒化物結晶	13.4 III-V窒化物結晶	13.4 III-V窒化物結晶	応用物理学会論文賞 JJAP論文賞 13.4 III-V窒化物結晶	13.4 III-V窒化物結晶	13.4 III-V窒化物結晶	13.4 III-V窒化物結晶	13.4 III-V窒化物結晶	13.4 III-V窒化物結晶
	H 4F-A402	270		合同セッションE「スピニエレクトロニクスの基礎と応用」	13.5 IV族結晶, IV-IV族結晶	13.5 IV族結晶, IV-IV族結晶	13.4 III-V窒化物結晶		13.4 III-V窒化物結晶		
	K 4F-A403	283	9.4 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	9.4 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長	13.3 III-V族エピタキシャル結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶	13.3 III-V族エピタキシャル結晶
8号館	L 1F-811	176	7.3 リソグラフィ	10.5 液晶	10.4 分子フォトニクス	10.4 分子フォトニクス	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性	10.2 評価・基礎物性		
	N 1F-813	108	11.7 シミュレーション		9.2 臨界電流, 超伝導応用	9.2 臨界電流, 超伝導応用	1.3 反応性プラズマの診断と計測	9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用	9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用		
	Q 1F-815	150	1.6 プラズマ現象一般	1.6 プラズマ現象一般	3.7 生体・医用光学	3.7 生体・医用光学	3.8 近接場光学	3.8 近接場光学	1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー		
	R 1F-816	150	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源	1.3 反応性プラズマの診断と計測	13.4 III-V窒化物結晶	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ			
	S 2F-821	165	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.7 生物・医用工学・バイオチップ	10.3 分子エレクトロニクス	10.3 分子エレクトロニクス	10.3 分子エレクトロニクス	10.3 分子エレクトロニクス	
	T 2F-822	165	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	3.6 視覚・色彩 3.5 情報光学	10.9 特定テーマB 分子・バイオナノテクノロジー	10.9 特定テーマB 分子・バイオナノテクノロジー			
	V 2F-823	733	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	「強誘電体薄膜の物性制御と次世代メモリデバイス」	6.1 強誘電体薄膜	応用物理学会論文賞 JJAP論文賞 6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	6.1 強誘電体薄膜	
	W 2F-824	164	3.2 材料光学	3.2 材料光学	3.3 機器・デバイス光学	3.3 機器・デバイス光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学	3.4 計測光学		
	X 2F-825	164	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	4.3 レーザー装置・材料	13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥	9.5 アナログ応用および関連技術	9.5 アナログ応用および関連技術		
	Y 2F-826	500	第14回応用物理学会講演奨励賞授賞式		6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	6.2 カーボン系薄膜	
	ZA 3F-831	1118	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	6.4 薄膜新材料	
	ZB 3F-832	220	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	4.4 超高速・高強度レーザー	応用物理学会論文賞 JJAP論文賞 4.4 超高速・高強度レーザー	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性	12.1 探索的材料物性	
	ZC 3F-833	164	合同セッションG「量子情報の基礎と応用」	合同セッションG「量子情報の基礎と応用」	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	6.5 表面物理・真空	4.6 レーザー分光応用・計測		
	ZD 3F-834	164		「最先端SiGe(C)技術とそのデバイス応用」	6.6 プローブ顕微鏡	6.6 プローブ顕微鏡	4.5 非線型光学	光・電子エレクトロニクス 業績賞授賞式・記念講演 4.5 非線型光学	4.5 非線型光学	4.5 非線型光学	
	ZE 3F-835	500	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	
	ZF 4F-841	220	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	応用物理学会論文賞 JJAP論文賞 12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	12.2 超薄膜・量子ナノ構造	合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」	合同セッションD「プラズマCVDの基礎と応用」	
	ZG 4F-842	105	9.3 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス	9.1 基礎物性	9.1 基礎物性	9.1 基礎物性	1.4 プラズマ応用プロセス	1.4 プラズマ応用プロセス			
	ZH 4F-843	105			7.8 ビーム応用一般・新技術	「多様化する理工系分野の人材開発と科学技術教育」	2.3 計測標準・精密計測	「量子標準体系の高度化」	2.1 計測一般		
	ZK 4F-844	160	7.1 X線技術	7.1 X線技術	7.6 プラズマ・イオン・光プロセス	7.6 プラズマ・イオン・光プロセス	3.1 物理光学・光学基礎 3.9 光学新領域	7.5 イオンビーム一般	7.5 イオンビーム一般	7.5 イオンビーム一般	
	ZL 4F-845	160	12.5 半導体光物性・光デバイス	12.5 半導体光物性・光デバイス	合同セッションE「スピニエレクトロニクスの基礎と応用」	合同セッションE「スピニエレクトロニクスの基礎と応用」	合同セッションE「スピニエレクトロニクスの基礎と応用」	「ナノスピントロニクスのデザインと創製」	合同セッションE「スピニエレクトロニクスの基礎と応用」		

日程表（会場別） 2

福岡大学 七隈キャンパス

会場	収容数	8月30日(土)		8月31日(日)		9月1日(月)		9月2日(火)		
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	
8号館	ZM 5F-851	220			4.2 フォトニック ナノ構造・現象	4.2 フォトニック ナノ構造・現象	4.2 フォトニック ナノ構造・現象	4.2 フォトニック ナノ構造・現象	4.2 フォトニック ナノ構造・現象	4.2 フォトニック ナノ構造・現象
	ZN 5F-852	105				「九州地区における高 分子材料の基礎及び 応用研究の最前線」	7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析	「超短パルスレー ザーの時空間制御 とその応用」		
	ZQ 5F-854	580	4.7 レーザー・ブ ロセッシング	4.7 レーザー・ブ ロセッシング	7.3 リソグラフィ	7.3 リソグラフィ	4.7 レーザー・ブ ロセッシング	4.7 レーザー・ブ ロセッシング	4.7 レーザー・ブ ロセッシング	
10号館	YA 1F-1011	320	合同セッションD「カー ボンナノチューブの基礎 と応用」 応用物理学学会業績賞	応用電子物性分科会60 周年記念講演会「応用電 子物性研究、今後の進 展・夢」	1.4 プラズマ応用 プロセス	第1回プラズマエレクト ロニクス賞受賞記念講演 「プラズマのバイオ応用の 新展開」	13.7 エピタキシー の基礎	「次世代量産ウェーハの 課題とその取り組み:ア ニール、エビ、および SOIウェーハ」	13.8 結晶評価, ナ ノ不純物・結晶欠陥	13.8 結晶評価, ナ ノ不純物・結晶欠陥
	YB 2F-1021	320	5.1 半導体レー ザー・発光素子	応用物理学論文賞 JJAP論文奨励賞 5.1 半導体レーザー・発 光素子	11.4 配線技術	応用物理学論文賞 JJAP論文奨励賞 11.4 配線技術	11.4 配線技術	11.4 配線技術		
	YC 2F-1023	128	15.7 磁場応用	磁場応用新領域グ ループ企画「強磁場応 用技術の新展開」	5.1 半導体レー ザー・発光素子	5.1 半導体レー ザー・発光素子	11.2 半導体表面	11.2 半導体表面	11.2 半導体表面	11.2 半導体表面
	YD 3F-1031	320	7.4 ビーム励起表 面反応	7.4 ビーム励起表 面反応	5.3 光記録	11.6 Siデバイス/ 集積化技術	11.6 Siデバイス/ 集積化技術	応用物理学論文賞 JJAP論文賞 11.6 Siデバイス/集積 化技術	11.6 Siデバイス/ 集積化技術	11.6 Siデバイス/ 集積化技術
	YE 3F-1033	128	8.1 磁性材料・磁 気デバイス	8.1 磁性材料・磁 気デバイス	8.2 誘電材料・誘 電体	8.2 誘電材料・誘 電体	14.1 基礎物性・評 価	14.1 基礎物性・評 価	14.3 デバイス	
	YF 3F-1034	128	8.4 ナノエレクト ロニクス	8.4 ナノエレクト ロニクス	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	8.5 熱電変換	8.6 新機能材料・ 新物性		
	YG 4F-1041	99		15.4 トライポロ ジ 15.3 新技術	15.5 エネルギー変 換・貯蔵 15.6 資源・環境	15.1 応用物理一般	1.1 放射線・加速 器・原子炉	10.6 高分子・ソフ トマテリアル	1.1 放射線・加速 器・原子炉	
	YH 4F-1042	128	5.4 光制御	5.4 光制御	5.5 光ファイバー	5.5 光ファイバー	5.2 光検出	14.2 プロセス技術 14.3 デバイス	7.7 微小電子源	7.7 微小電子源
	YK 4F-1043	250	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	応用物理学論文賞 解説論文賞 5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御	5.4 光制御
11号館	YL 1F-1111	192	10.1 作製技術	応用物理学論文賞 解説論文賞 11.3 絶縁膜技術	10.8 特定テーマA 有機デバイス	応用物理学論文賞 JJAP論文奨励賞 10.8 特定テーマA有機デ バイス	10.8 特定テーマA 有機デバイス	有機分子・バイオエレクト ロニクス分科会論文賞 10.8 特定テーマA有機デ バイス	10.8 特定テーマA 有機デバイス	10.8 特定テーマA 有機デバイス
第一記念会堂(体育館)	ポスター セッション	13.1 バルク結晶成長	[前半] 10.1 作製技術	11.3 絶縁膜技術	[前半] 5.3 光記録	11.3 絶縁膜技術	[前半] 3.1 物理光学・光学基 礎 3.9 光学新領域 6.3 酸化物エレクトロ ニクス	6.3 酸化物エレクトロ ニクス	[後半] 1.1 放射線・加速器・ 原子炉 8.3 微粒子・粉体	
			[後半] 7.3 リソグラフィ 11.3 絶縁膜技術							

会場は福岡大学七隈キャンパスです。(23p 参照)
総合受付は8号館です。講演会場は分散しています。会場間の移動の際にはこのことを十分お含み置き下さい。

応用物理学会スクールは、9月1日(月)、2日(火)に開催します。(11, 12p 参照)。

プログラム編成の都合により、一般講演の中には講演申込みの際の希望分科によらないで、編集されているものもあります。お申込みの講演が希望分科に含まれていないようでしたら、関連分科をお調べください。

この講演会では口頭講演の場合、一部のシンポジウムを除き、オーバーヘッドプロジェクター(OHP)のみを使用します。スライドプロジェクターは使用できません。講演される方はこのことを十分念頭に置かれて準備に当ててください。OHPの使用に関するご案内をご覧ください。(16p 参照)

ポスターセッションでは一部を除き1講演につき、5分の口頭講演(ショートプレゼンテーション)を行います。(16p 参照)

学内には駐車できる敷地・設備はありません。ご注意ください。

会期中、電話のとりつぎはいたしません。ただし呼出しビラの掲示による連絡は行っておりますので、ご利用ください。

聴講者の講演会場内での撮影、録音についてはご遠慮いただいておりますので、お含み置きください。

参加費について

学術講演会に出席される方は参加費:応用物理学会正会員3,000円、会員外5,000円、学生1,000円を総合受付にお払いこみください。

なお、APS (American Physical Society), EPS (European Physical Society), IOP (Institute of Physics), EDS (Electron Devices Society/IEEE), LEOS (Lasers and Electro-Optics Society/IEEE), OSA (Optical Society of America), KPS (Korean Physical Society) 会員は応用物理学会正会員扱いとなります。

参加費をお払いこみの方には参加票挟み込みの予稿集第0分冊[シンポジウム予稿と全分冊の予稿目次(分科別プログラム)を含む]1部をお渡しいたします。なお、同第0分冊を予約されている方は、当日予約受付にて引換券を提出してください。第0分冊(参加票挟み込み)をお渡しします。参加票には各自ご記名いただき会期中胸ポケットにつけておかれるようお願いいたします。

応用物理学会評議員・代議員合同会議

と き 平成 15 年 8 月 30 日 (土) 16:30 ~ 17:30
と ころ 福岡大学七隈キャンパス 文系センター棟 4 階
第 4 会議室
福岡市城南区七隈 8-19-1

第 25 回応用物理学会「論文賞」授賞式

と き 平成 15 年 8 月 30 日 (土) 17:30 ~ 17:50
と ころ 福岡大学七隈キャンパス 文系センター棟 4 階
第 4 会議室
福岡市城南区七隈 8-19-1

懇親会

参加者の親睦をはかるため、気軽な懇親会を計画いたしました。ふるってご参加ください。(定員 250 名、定員になり次第締切ります)

と き 平成 15 年 8 月 30 日 (土) 18:00 ~ 19:30
と ころ 福岡大学七隈キャンパス 文系センター棟 16 階
スカイラウンジ
福岡市城南区七隈 8-19-1

会費・申込 2,500 円 当日正午までに総合受付へ

第 14 回応用物理学会「講演奨励賞」 賞状・記念品の贈呈式(公開)

と き 平成 15 年 8 月 30 日 (土) 12:30 ~ 13:30
と ころ 福岡大学七隈キャンパス 8号館2階826教室(Y会場)

展示会

恒例により、本講演会開催に併せて学内に展示会を開催します。気軽にご来場ください。

と き 平成 15 年 8 月 30 日 (土) ~ 9 月 2 日 (火)
(最終日は正午まで)
と ころ 福岡大学七隈キャンパス 第一記念会堂(体育館)

講演予稿集について

4分冊頒布となっています。(頒布方法については本誌1月号に掲載)分冊内容と頒価は下記の通りです。なお、第0分冊予約には参加費が含まれています。

	4分冊:各分冊ともA4判,シンポジウムは1頁2件,一般は1頁3件の予稿を掲載		
	含まれる分科および内容	予約頒価 (1冊)	即売頒価 (1冊)
※ 第0分冊	全シンポジウム,全分冊の予稿 目次(分科別プログラム)	正会員 2,500円 学生 1,000円 会員外 5,000円	正会員 3,000円 学生 1,000円 会員外 5,000円
第1分冊	放射線・プラズマエレクトロニクス,計測・制御,応用物性,超伝導,結晶工学,応用物理一般,合同セッションD・E・F・G	3,500円	4,000円
第2分冊	薄膜・表面,ビーム応用,半導体A(シリコン),非晶質,合同セッションD・F	3,500円	4,000円
第3分冊	光,量子エレクトロニクス,光エレクトロニクス,有機分子・バイオエレクトロニクス,半導体B(探索的材料・物性・デバイス),合同セッションE・F・G	3,500円	4,000円

- ※前出「参加費について」をご参照ください。
- シンポジウムは第0分冊に掲載します。
- 放射線・プラズマエレクトロニクス,薄膜・表面および非晶質の合同セッションDは,第1・2分冊に掲載します。応用物性と半導体Bの合同セッションEは,第1・3分冊に掲載します。放射線・プラズマエレクトロニクス,薄膜・表面,ビーム応用,応用物性,半導体Bの合同セッションFは,第1・2・3分冊に掲載します。量子エレクトロニクス,応用物性,超伝導と半導体Bの合同セッションGは,第1・3分冊に掲載します。
- 予約郵送(事後)の場合は他に郵送料(諸掛かり含む)がかかります。
- 予約申込をされなかった方は当日早目に即売にてお求めください。なお,予約された方は引換券(応用物理学会より送付したものを必ずご持参ください)。

■ 講演募集分科名・プログラム編集委員

大分類分科名	中分類分科名・プログラム編集委員
1. 放射線・プラズマエレクトロニクス	<p>1.1 放射線・加速器・原子炉（放射線発生装置，放射線物理，放射線検出器，信号処理，放射線利用・遮蔽，線量，医学利用，保健物理，ビーム利用，核融合工学，中性子工学，原子炉計測） 1.2 プラズマ生成技術およびプラズマ源（プラズマ発生制御技術，反応性プラズマ生成法，モデリング・シミュレーション） 1.3 反応性プラズマの診断と計測（プラズマ診断法，粒子計測技術，気相および表面反応計測） 1.4 プラズマ応用プロセス（エッチング，CVDおよびPVD，プラズマプロセス装置） 1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー（ナノチューブ，フラレン，プラズマナノ加工技術） 1.6 プラズマ現象一般（原子分子・放電過程，光源，ディスプレイ，マイクロプラズマ，レーザープラズマ，プラズマ環境応用）</p>
<p>委員：1.1 河原林順（名大院工），佐々木慎一（高エネ研） 1.2 進藤春雄（東海大電子情報） 1.3 中野俊樹（防衛大） 1.4 大森達夫（三菱先端総研） 1.5 白谷正治（九大システム情報），林 康明（京工繊大） 1.6 飯塚 哲（東北大工）</p>	
2. 計測・制御	<p>2.1 計測一般（測定原理，計測手法，測定装置，計測システム，センサー，機器分析，デバイス，微小領域など） 2.2 制御・情報処理応用計測（インテリジェント計測，遠隔制御，機器制御，パターン認識，情報処理，カオスなど） 2.3 計測標準・精密計測（単位，標準，不確かさ，校正，基礎物理定数，物性定数，精密測定など）</p>
<p>委員：2.1, 2.2, 2.3 田村 取（産総研），細川端彦（通信総研）</p>	
3. 光	<p>3.1 物理光学・光学基礎（散乱，偏光，コヒーレンス，電磁界解析，回折理論，光と電子の相互作用，光領域における時空間変換など） 3.2 材料光学（屈折率・複屈折・構造・吸収の変化及びその利用，光導波路，光メモリ，ホログラム，グレーティング，ディスプレイ（液晶，EL，電子線，LED，MEMS，その他）など） 3.3 機器・デバイス光学（光学機器，光学モジュール，光学素子，光学系，およびそれらの設計，製作，評価） 3.4 計測光学（干渉計測，偏光計測，分光計測，スペックル・散乱，吸光スペクトル，フェムト秒計測，ナノ計測，屈折率・膜厚計測，距離・変位計測，速度計測，粒径計測，顕微鏡，光センサー，光計測システム） 3.5 情報光学（光情報処理，画像処理，ホログラフィー，光コンピューティング，ビジョンチップ，立体表示，画像復元・検出） 3.6 視覚・色彩（網膜，生理光学，眼光学，視力，視機能，両眼視，立体視，コントラスト感度，ロービジョン，眼球運動，運動視，時間弁別能，パターン認識，順応，恒常性，検出，視覚探索，分光感度，色弁別能，色覚，色彩，調色，照明，視環境，視覚認知，視覚モデル） 3.7 生体・医用光学（生体計測，生体分光，断層画像，トモグラフィー，ピコ秒・フェムト秒生体計測，生体画像，医用光学機器，μTAS，バイオMEMS） 3.8 近接場光学（エバネッセント場，プラズモン，ボラリトン，電磁場相互作用，光プローブ，走査型顕微鏡，高密度光記録，ナノメートル光加工，電子ドット，原子捕捉，フォトリソグラフィ） 3.9 光学新領域（レーザートラップ，レーザーマニピュレーション，新技術，微小領域の光学，光と微粒子の相互作用，微小共振器など）</p>
<p>委員：3.1 原口雅宣（徳島大工） 3.2 江上 力（静大工），藤掛英夫（NHK 技研） 3.3 石井哲也（オリンパス） 3.4 三尾典克（東大新領域），伊藤雅英（筑波大理工工） 3.5 野村孝徳（和歌山大工） 3.6 金子寛彦（東工大像情報） 3.7 Rajagopalan Uma Maheswari（理研） 3.8 齋木敏治（慶大） 3.9 坂口幸幸（産総研）</p>	
4. 量子エレクトロニクス	<p>4.1 量子光学・原子光学（コヒーレント効果・現象，量子相関，スクイーズド状態，量子コンピューティング，量子通信，原子光学，レーザー冷却など） 4.2 フォトリソグラフィ・構造・現象（フォトリソグラフィ，ナノフォトニクス，極微レーザー・共振器・光回路，放射場制御，多次元構造プロセスと材料など） 4.3 レーザー装置・材料（固体・気体・液体レーザー，ファイバーレーザー，レーザー励起技術，新光機能材料・素子，周波数制御レーザー，自由電子レーザーなど） 4.4 超高速・高強度レーザー（超短パルスレーザー，高強度・高エネルギーレーザー，超高速ファイバー非線形光学，超短光パルス制御・計測，XUV・X線レーザー，レーザーエネルギー応用など） 4.5 非線形光学（波長変換技術，非線形光学材料・評価，テラヘルツ発生・応用，レーザーカオス，位相共役など） 4.6 レーザー分光応用・計測（分子・原子分光応用，光誘起化学，環境計測・産業計測，ライダー，レーザー顕微鏡，レーザー生体計測など） 4.7 レーザー・プロセッシング（レーザーアブレーション加工，マイクロマシーニング，超微粒子・薄膜作製，熱加工，医用応用，加工基礎・モニタリングなど）</p>
<p>委員：4.1 古澤 明（東大工） 4.2 納富雅也（NTT 物性基礎研），馬場俊彦（横国大工） 4.3 窪寺昌一（宮崎大工），尾松孝茂（千葉大） 4.4 小林洋平（産総研），近藤公伯（阪大） 4.5 武者 満（電通大レーザー新世代研） 4.6 長澤親生（都立大工），渡辺昌良（通総研関西） 4.7 杉岡幸次（理研），新納弘之（産総研）</p>	
5. 光エレクトロニクス	<p>5.1 半導体レーザー・発光素子（半導体レーザー，半導体光アンプ，発光ダイオード，発光素子用材料，発光素子用量子構造，作製技術，信頼性，発光素子の基礎と応用） 5.2 光検出（フォトダイオード，APD，超高速光検出器，光伝導素子，イメージセンサー，光電変換素子，新太陽電池，材料・プロセス技術，光検出の基礎と応用） 5.3 光記録（光ディスク，光記録材料・基板，光部品／光集積部品，光ヘッド，光記録システム，超高密度記録，光記録の基礎と応用） 5.4 光制御（光導波路，合分波器，光集積回路，光スイッチ，光MEMS，光変調器，波長変換素子，非線形光学素子，超高速光制御素子，新規光デバイス，材料・プロセス技術，光制御の基礎と応用） 5.5 光ファイバー（石英系ファイバー，POF，光ファイバー材料，ファイバーレーザー，ファイバー光アンプ，光ファイバー素子，光ファイバーセンサー，光ファイバーの基礎と応用）</p>
<p>委員：5.1 佐々木達也（NEC 光・無線研） 5.2 小山二三夫（東工大） 5.3 小野雄三（立命館大） 5.4 勝山俊夫（東大生研），神徳正樹（NTT フォトニクス研），栗村 直（物材機構） 5.5 中村一則（古河電工）</p>	
6. 薄膜・表面	<p>6.1 強誘電体薄膜（強誘電体・高誘電率薄膜，電極材料など） 6.2 カーボン系薄膜（ダイヤモンド，ナノチューブ，非晶質カーボンなど） 6.3 酸化物エレクトロニクス（機能性酸化物薄膜，光触媒など） 6.4 薄膜新材料（新材料・新技術，薄膜一般） 6.5 表面物理・真空（表面，界面，真空，表面ナノ構造，計測法・理論，表面一般など） 6.6 プローブ顕微鏡（走査型プローブ顕微鏡，ナノサイエンス，ナノテクノロジー，ナノプローブ，表面・界面評価，原子分子操作など）</p>
<p>委員：6.1 木島 健（セイコーエプソン），舟窪 浩（東工大総理工） 6.2 澤辺厚仁（青学大理工），小海文夫（三重大工） 6.3 澤田 豊（東京工芸大），吉本 護（東工大応セラ研） 6.4 神谷利夫（東工大応セラ研），藤田安彦（都立科技大） 6.5 長谷川修司（東大理），片山光浩（阪大工） 6.6 重川秀実（筑波大理工工），吉村雅満（豊田工大）</p>	

7. ビーム応用	7.1 X線技術 (X線源, X線光学素子, X線結像光学系, X線検出器, X線顕微鏡, X線利用技術) 7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析 (電子顕微鏡技術, ビーム利用分析技術, 評価解析手法, 表面・界面分析, 極微小構造分析, 極微量分析) 7.3 リソグラフィ (光, EUV, 電子ビーム, イオンビーム, X線, インプリントリソグラフィ, マスク技術, レジスト) 7.4 ビーム励起表面反応 (原子・分子ビーム, 電子ビーム, イオンビーム, レーザー, 放射光, 表面反応, 表面原子操作, 極薄膜形成, エッチング, 粒子線散乱, 原子・分子-表面相互作用) 7.5 イオンビーム一般 (イオン源, イオンビーム応用装置, イオン・固体相互作用, イオン注入, イオンビーム蒸着, イオンビーム加工, イオンビーム分析, イオンビームの理論・物理) 7.6 プラズマ・イオン・光プロセス (エッチング, 微細加工, 成膜, CVD, レーザーアブレーション, 表面改質, PFC対策・代替, 環境処理技術, MEMS・バイオ・ナノデバイスプロセス, 照射損傷, 中性ビーム, 大気圧・熱プラズマプロセス) 7.7 微小電子源 (電子源作製技術, 電子源評価技術, 電子源材料, 表示デバイス, 高周波デバイス, 電子源応用技術, 電子放出の理論・物理, 新しい電子源) 7.8 ビーム応用一般・新技術 (粒子ビーム技術, 光ビーム技術, ビーム応用機器, ビーム関連評価技術)
委員: 7.1, 7.2 三浦永祐 (産総研) 7.3 中尾修治 (ルネサステクノロジー), 菊池幸子 (ASET), 小笠原宗博 (東芝研開セ) 7.4 寺岡有殿 (原研) 7.5 後藤康仁 (京大工) 7.6 関根 誠 (東芝セミコン社) 7.7 後藤康仁 (京大工) 7.8 寺岡有殿 (原研)	
8. 応用物性	8.1 磁性材料・磁気デバイス 8.2 誘電材料・誘電体 (強誘電体) 8.3 微粒子・粉体 8.4 ナノエレクトロニクス (単電子輸送, 量子輸送, 量子コンピューティング, スピンデバイス, NEMS, ナノバイオデバイス, 分子デバイス, デバイス物理, ナノデバイス形成技術, 量子デバイスを利用した新アーキテクチャなど) 8.5 熱電変換 (材料, モジュール, システム, 輸送特性 (熱, 電子, 熱起電力), 計測技術, 熱電・熱電子発電, AMTEC, 熱電冷却, ペルチェ素子など) 8.6 新機能材料・新物性 (金属, セラミックス, 低温物性など)
委員: 8.1 田中秀和 (阪大産研), 岩崎仁志 (東芝研開セ) 8.2 安達正利 (富山県立大工) 8.3 岡野一雄 (職業能力開発大) 8.4 川浦久雄 (NEC基礎研), 藤澤利正 (NTT物性基礎研) 8.5 李 鎔勲 (コマツ中研), 三木一司 (物材機構) 8.6 鈴木 薫 (日大理工)	
9. 超伝導	9.1 基礎物性 (超伝導基礎物性, 新現象, 物理, 化学, 固有接合, 高周波応答, 基礎理論, 単結晶やバルクを用いた基礎研究, 超伝導関連物質, 結晶育成, インターカレーション, 新評価技術など) 9.2 臨界電流, 超伝導応用 (磁束ピンニング, Jc, 交流損失, 不可逆磁界, 安定性, 機械的特性, 線材, バルク, 大容量導体, 超伝導マグネット, コイル巻線, 電流リード, 磁気シールド, 磁気軸受け, 試験・評価方法など) 9.3 新材料, 新薄膜, 新低温動作デバイス (MgB ₂ , 新超伝導材料, 新材料薄膜, 新材料探索指針, 高T _c 化新薄膜, FET超伝導, 新低温動作デバイスと動作原理など) 9.4 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長 (超伝導薄膜・厚膜の高性能化プロセス, 高品質結晶成長, 表面成長, テープ作製プロセス, 膜成長評価, 長尺化, 大面積化, バッファ層など) 9.5 アナログ応用および関連技術 (SQUID, SQUID応用, 検出器, 受信器, ミキサ, フィルター, 共振器, 電圧標準, 評価技術, 磁気シールド技術, アナログ計測システム, 新デバイス, 冷却技術 (冷凍機) など) 9.6 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用 (単一磁束量子回路, 超伝導A/D変換器, SQUID, ジョセフソン素子, 超伝導素子など)
委員: 9.1 高野義彦 (物材機構) 9.2 木須隆暢 (九大) 9.3, 9.4 向田昌志 (山形大), 吉田 隆 (名大) 9.5 師岡利光 (セイコーインスツルメンツ) 9.6 齋藤和夫 (日立基礎研)	
10. 有機分子・バイオエレクトロニクス	10.1 作製技術 (ドライまたはウェットプロセス (真空蒸着, CVD, スピンコート, ディッピング, LB, 自己組織化 (SAM) など) を用いた各種薄膜作製技術, 分子配列・配向制御, 超微粒子, 無機有機複合膜など) 10.2 評価・基礎物性 (SPM, 電子線・X線回折, 構造解析, 各種分光学的評価技術, 基礎物性理論・評価, 応用物性など) 10.3 分子エレクトロニクス (分子設計, 分子・ナノ構造体・界面の電子物性, 光電子材料・デバイス (電界発光, 光電変換, トランジスタ, 等) の構造・基礎物性制御, など) 10.4 分子フォトニクス (非線形光学, フォトリフラクティブ, 光構造変化, 発光 (蛍光・燐光, 電界発光など)・誘導放出, 光導波路・微小共振器材料, デバイスならびに光センサー, 光記録用材料) 10.5 液晶 (材料・物性・デバイス) 10.6 高分子・ソフトマテリアル (高分子エレクトロニクス, 導電性高分子, ポリシラン, 電子光機能性高分子, 炭素材料および機能応用, ゲル, コロイド, 複雑系など) 10.7 生物・医用工学・バイオチップ (バイオマテリアル・エレクトロニクス・センサー, 生体・医用の機能・物性・材料, 遺伝子・タンパク質・超分子工学, バイオチップ, μ -TAS (マイクロ化学分析システム) など) 10.8 特定テーマA有機デバイス (発光素子・ディスプレイ (有機EL・高分子LED), 有機薄膜太陽電池, 有機TDT・FET, 有機半導体レーザー, 光回路 (光導波路, POF), メモリー, センサーなどデバイス・モジュール・システム) 10.9 特定テーマB分子・バイオナノテクノロジー (分子ナノテクノロジー (単一分子, 量子構造, ナノチューブ, 超微粒子・超分子などのエレクトロニクス・フォトニクス), バイオナノテクノロジー (ナノバイオエレクトロニクス, バイオナノプロセス, その他のバイオ・ナノ融合技術, および生体分野に関する以下の技術/1分子マニピュレーション, 1分子分光, 1分子イメージング, 多光子・エバネッセント顕微鏡, 光ピンセット, 超分子, 超微粒子), 並びにその境界領域)
委員: 10.1 島田敏宏 (東大理), 白鳥世明 (慶応大理工) 10.2 小林 圭 (京大IIC), 石井久夫 (東北大通研) 10.3 冨田博一 (分子研), 蔵田哲之 (三菱電機) 10.4 福田隆史 (産総研光技術), 原田建治 (北見工大) 10.5 尾崎雅則 (阪大工) 10.6 加藤景三 (新潟大工) 10.7 澤田和明 (豊橋技科大), 服部励治 (九大システム情報) 10.8 筒井哲夫 (九大総理工), 時任静士 (NHK技研), 安達千波矢 (千歳科技大) 10.9 石田敬雄 (産総研機械システム), 味戸克裕 (NTT物性基礎研)	
11. 半導体 A (シリコン)	11.1 基礎物性・評価 (新規物性, 新材料, 材料物性, 新機能, 新評価法, ナノ構造, 初期過程, 表面現象, 理論・シミュレーションなど) 11.2 半導体表面 (評価技術, 清浄化, 反応初期過程と界面物性, 汚染検出・除去技術, 吸着・解離過程, 表面微細構造, 薄膜形成基礎と界面特性, 表面観察技術など) 11.3 絶縁膜技術 (ゲート絶縁膜, キャパシタ絶縁膜, 素子分離, 成膜手法, 評価手法, 電気特性, high-k膜, オキシナイトライド膜, 信頼性, 構造解析など) 11.4 配線技術 (配線, コンタクト, シリサイド, 層間絶縁膜, CMP, Low-k膜, 信頼性技術など) 11.5 Siプロセス技術 (プロセス導入欠陥, エピ, SOI, 不純物添加, イオン注入, 過渡的増速拡散, 浅接合形成, ポリシリコン, TFT, CVDなど) 11.6 Siデバイス/集積化技術 (新デバイス構造, デバイス集積化技術, デバイス動作原理, 動作時の諸現象, 信頼性技術, 回路設計技術, Siナノデバイス, 量子効果デバイスなど) 11.7 シミュレーション (プロセスシミュレーション, デバイスシミュレーション, 回路シミュレーション, モデリング, 量子効果など)
委員: 11.1 廣瀬和之 (宇宙研) 11.2 中村 徹 (法政大工), 廣瀬和之 (宇宙研) 11.3 金田千穂子 (富士通研), 佐竹秀喜 (東芝研開セ) 11.4 古澤健志 (ルネサステクノロジー), 小川真一 (松下電器 Selete) 11.5 永瀬雅夫 (NTT物性基礎研), 松尾直人 (山口大工) 11.6 山下朋弘 (ルネサステクノロジー), 山本豊二 (NECシリコンシステム研) 11.7 鎌倉良成 (阪大工)	

12. 半導体B (探索的材料・物性・デバイス)	12.1 探索的材料物性 (新材料〔新しい合成法を含む〕, 理論的・実験的手法による新しい物性の探索, 不純物, 欠陥, 深い準位, キャリア輸送, 評価手法, シリサイド系半導体, ナノチューブエレクトロニクスなど) 12.2 超薄膜・量子ナノ構造 (量子閉じこめ効果, 低次元電子物性, トンネル効果, ナノ材料・デバイスなど) 12.3 プロセス技術・界面制御 (エッチング, 電極形成, イオン注入, ウエハ張り合わせ, ナノ構造プロセス, 表面・界面物性, 保護膜形成, プロセス損傷評価など) 12.4 超高速・機能デバイス (ワイドギャップ電子デバイス・回路, III-V族高速デバイス・回路, Si系ヘテロ高速デバイス・回路, 機能デバイス・回路, 新材料デバイス・回路など) 12.5 半導体光物性・光デバイス (III-V族およびII-VI族半導体の光物性, シリコン系材料, 希土類添加効果, EL素子, 蛍光体, 多元化合物, シリコン・ノンシリコン系太陽電池など)
委員: 12.1 秋永広幸 (産総研), 財部健一 (岡山理科大), 前田佳均 (大阪府大総合科学) 12.2 栗野祐二 (富士通研), 齊藤 正 (NTT先端総研), 竹内 淳 (早大理工), 深津 晋 (東大院総合文化), 12.3 塩島謙次 (NTTフォトニクス研) 12.4 江川孝志 (名工大), 吉川俊英 (富士通研) 12.5 小山英樹 (兵庫教育大), 岡本信治 (NHK放送技研), 一色秀夫 (電通大電気通信), 鎌田憲彦 (埼玉大工), 松下裕亮 (東海大開発工)	
13. 結晶工学	13.1 バルク結晶成長 13.2 II-VI族結晶 (多元系酸化物半導体結晶を含む) 13.3 III-V族エピタキシャル結晶 13.4 III-V窒化物結晶 13.5 IV族結晶, IV-IV族結晶 (Siエビ, SiGe (C), 歪Si, デバイスなど) 13.6 IV族系化合物 (SiC結晶成長, プロセス, デバイス, 評価など) 13.7 エピタキシーの基礎 (機構, 理論, シミュレーション, 成長法) 13.8 結晶評価, ナノ不純物・結晶欠陥
委員: 13.1 小澤哲夫 (静岡理工科大) 13.2 鍋谷暢一 (山梨大工), 藤田静雄 (京大国際融合) 13.3 塚本史郎 (東大生研), 中田義昭 (富士通研) 13.4 綱瀬明伯 (農工大), 家近 泰 (アセック), 碓井 彰 (古河機械金属), 本田 徹 (工学院大), 宮嶋孝夫 (ソニーCNC) 13.5 酒井 朗 (名大工) 13.6 土田秀一 (電力中研) 13.7 塚本史郎 (東大生研) 13.8 柿本浩一 (九大応用力学研)	
14. 非晶質	14.1 基礎物性・評価 (構造, 欠陥, 構造変化, 電子物性, 光物性, 輸送現象, 評価法など) 14.2 プロセス技術 (製膜機構, 製膜プロセス (プラズマ, 光, ホットワイヤ, レーザアニール, ゴルゲル), 気相・表面診断法, ナノ結晶, 微結晶, 多結晶, 表面・界面, 多層膜, 新材料) 14.3 デバイス (TFT, 太陽電池, メモリー, 電子写真, 発光素子, ファイバー素子, 各種センサーなど)
委員: 14.1 嶋川晃一 (岐阜大工), 泰 信宏 (産総研) 14.2 白井 肇 (埼玉大工), 増田 淳 (北陸先端大) 14.3 脇坂健一郎 (三洋電機), 府川 真 (旭硝子中研), 藤掛伸二 (富士電機総研)	
●これまでの14.2材料設計, 14.3プロセス技術, 14.5新領域を統合して, 新たに14.2プロセス技術としました。新しい14.2プロセス技術では, 多結晶, レーザアニールなどもキーワードに加え, 薄膜シリコン系材料全般の作製技術や, その診断法また新構造材料などについて総合的に議論し, 14.1基礎物性・評価と14.3デバイスの橋渡しの役割を担いたいと考えています。14.2プロセス技術の新たなキーワードを御参考に積極的な投稿をお願い致します。	
15. 応用物理一般	15.1 応用物理一般 (熱, 音響, 超音波, 液体, 静電気など) 15.2 教育 (システム, 方法, 教材開発, 物理実験, 情報教育) 15.3 新技術 (センサー, 新教材・デバイスとプロセス技術, 新技術計測・検出・評価法, 新機構開発) 15.4 トライボロジー (変換素子, マイクロマシンなど) 15.5 エネルギー変換・貯蔵 15.6 資源・環境 15.7 磁場応用 (磁場効果, 磁気エネルギー, 磁場配向, 磁気科学, 磁場中計測, 強磁場)
委員: 15.1 浅香 隆 (東海大工) 15.2 喜岡俊英 (東理大工) 15.3 三科博司 (千葉大工) 15.4 河野彰夫 (理研) 15.5 小原宏之 (玉川大工) 15.6 佐藤芳之 (NTT-AT) 15.7 廣田憲之 (東大新領域)	

プログラム編集委員の下線は代表

②合同セッションに関する一般講演

合同セッションD 「プラズマCVDの基礎と応用」	放射線・プラズマエレクトロニクスの1.4プラズマ応用プロセス, 薄膜・表面の6.2カーボン系薄膜, および非晶質の14.2プロセス技術とて企画した合同セッションです。 上記の3分科では, 従来からプラズマCVD技術の基礎と応用に関する講演, 討論が活発に行われています。1.4ではプラズマCVDの気相, 表面反応過程を中心としているのに対して, 6.2ではカーボン系薄膜の作製と評価, 14.2ではシリコン系薄膜の作製と評価に力点が置かれています。プラズマCVD技術のさらなる発展のために, 分科を越えて同一会場でも有機的で相補的な議論ができるように本合同セッションを企画しました。低圧のプラズマCVDを中心として, その基礎と応用に関する講演を広く募集いたします。本セッションの予稿は, 第1分冊・第2分冊に掲載します。
合同セッションE 「スピンエレクトロニクスの基礎と応用」	応用物性の8.1磁性材料・磁気デバイスと半導体Bの12.1探索的材料物性とて企画した合同セッションです。最近, 電子の持つスピン自由度を活用したデバイス開発を目指した研究が盛んになってきました。材料の観点からそれらを類別しますと, 酸化物などの強相関電子系材料や磁性金属を用いた研究と, 半導体をベースにした研究に分けることができますが, その前者が8.1で, 後者が12.1で各々に議論されているのが現状です。そこで, スピンエレクトロニクスという新しいキーワードのもとに, 分科を越えて同一会場で議論ができるよう本合同セッションを企画いたしました。応用物理学会ならではの, 多方面にわたる分野への議論の広がり期待して, 上記材料や磁性有機物等におけるスピン依存物性, 強磁性接合や磁気記録媒体をはじめとする光・電子・磁気・量子スピンデバイス, スピンナノ構造の作製・計測・物性評価技術, 光スピンを用いた量子通信/量子コンピュータ等, 基礎と応用にわたる講演を広く募集いたします。 本セッションの予稿は, 第1分冊・第3分冊に掲載します。

<p>合同セッションF 「カーボンナノチューブの基礎と応用」</p>	<p>放射線・プラズマエレクトロニクス の 1.5 プラズマプロセスによるナノテクノロジー，薄膜・表面の 6.2 カーボン系薄膜，6.6 プローブ顕微鏡，ビーム応用の 7.7 微小電子源，応用物性の 8.4 ナノエレクトロニクス，半導体Bの 12.1 探索的材料物性とて企画した合同セッションです。</p> <p>上記の分科では，従来からカーボンナノチューブの基礎と応用に関する講演，討論が活発に行われています。1.5 や 6.2 では材料成長技術，6.6 ではプローブ顕微鏡探針応用，7.7 では電界放射応用，8.4 や 12.1 では物性や電子デバイス応用などにそれぞれ力点がおかれています。今後のこの分野の発展のためには，材料技術，プロセス技術，デバイス技術の発表が行われる場として，応用物理学会の独自性，重要性は極めて高いものと考えます。そこでこれらが分科を越えて同一会場で議論できるように，本合同セッションを企画しました。カーボンナノチューブの材料，物性，デバイス応用など，基礎と応用に関する講演を広く募集いたします。本セッションの予稿は，第1分冊・第2分冊・第3分冊に掲載します。</p>
<p>合同セッションG 「量子情報の基礎と応用」</p>	<p>4.1 量子光学・原子光学，8.4 ナノエレクトロニクス，9.3 新低温動作デバイス，9.6 接合，回路作製プロセスおよびデジタル応用，12.2 超薄膜・量子ナノ構造で企画した合同セッションです。</p> <p>近年，いわゆる「ナノテク」が進歩し，我々の扱う対象も量子力学領域に入りつつあります。これは，古典力学から量子力学へのパラダイムシフトであり，今後テクノロジーの分野でも量子力学的視点が重要になっていくと考えられます。特に情報通信や情報処理の分野ではその動きが顕著で，量子情報通信・量子コンピューターなどの量子情報テクノロジーが精力的に研究されています。これらの研究は今まで，扱っている系により異なった角度から議論されており，「量子情報テクノロジー」という同一の視点から議論されてはいませんでした。そこで，本セッションでは，「量子情報テクノロジー」というキーワードのもとに，扱っている系にとらわれず議論することを意図しています。したがって，物性からシステムまで「量子情報テクノロジー」に関係する講演を広く募集いたします。具体的には，量子情報基礎として量子計測・制御および非古典状態生成などの理論・実験，基盤技術・素材として量子ビット作製および量子ビット用材料物性（光子，NMR，超伝導，電子系，スピン系，励起子系など），量子情報実験として量子プロトコルの実証実験などを考えておりますが，必ずしもこれらには限定しません。本セッションの予稿は，第1分冊・第3分冊に掲載します。</p>